

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

J1046 U.S. PTO  
09/835491  
04/17/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2000年 4月17日

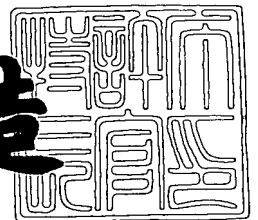
出 願 番 号  
Application Number: 特願2000-115207

出 願 人  
Applicant(s): セイコーエプソン株式会社

2001年 3月23日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3023996

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0078797

【提出日】 平成12年 4月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/133

【発明者】

    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

    【氏名】 小澤 欣也

【発明者】

    【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

    【氏名】 前田 強

【特許出願人】

    【識別番号】 000002369

    【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

    【代表者】 安川 英昭

【代理人】

    【識別番号】 100093388

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 鈴木 喜三郎

    【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

    【識別番号】 100095728

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【選任した代理人】

    【識別番号】 100107261

    【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9711684

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶装置、投射型表示装置及び電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 相対向する面にそれぞれ配向膜が設けられた一对の基板間に液晶が挟持されてなり、複数の走査線と、複数のデータ線と、これら走査線およびデータ線により区画された画素領域毎に設けられたスイッチング素子および画素電極とを有する液晶装置であって、前記配向膜によるプレチルト角が  $20^{\circ}$  以上  $30^{\circ}$  以下になっていることを特徴とする液晶装置。

【請求項 2】 前記配向膜が酸化シリコンまたは窒化シリコンからなることを特徴とする請求項 1 記載の液晶装置。

【請求項 3】 前記一对の基板間に挟持される液晶層の厚さを  $d$  とし、前記画素電極同士の間隙を  $L$  としたときに、 $d/L \geq 1$

なる関係を満たすことを特徴とする請求項 2 に記載の液晶装置。

【請求項 4】 前記画素電極が光反射性の金属電極であることを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の液晶装置。

【請求項 5】 請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の液晶装置を備えたことを特徴とする投射型表示装置。

【請求項 6】 光源と、前記光源からの光を変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射レンズとが具備され、前記光変調装置として請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載された液晶装置が用いられたことを特徴とする投射型表示装置。

【請求項 7】 光源と、前記光源からの光を変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射レンズとが具備され、前記光変調装置として請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載された液晶装置が青系の表示部に用いられたことを特徴とする投射型表示装置。

【請求項 8】 請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の液晶装置を備えたことを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、配向膜のプレチルト角、さらには、画素電極同士の間隙、液晶層の厚さを特定の関係に規定した液晶装置と、それを用いた投射型表示装置と電子機器に関し、特に、ディスクリネーションラインに起因する表示欠陥の発生を抑制した技術に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

従来から、液晶表示装置は、直視型のみではなく、プロジェクションテレビ等の投射型表示素子としても需要が高まってきている。ここで、液晶表示装置を投射型表示素子として使用する場合に、従来の画素数で拡大率を高めると、画面の粗さが目立ってくる。そこで、高い拡大率でも精細な画像を得るためには、画素数を増やすことが必要となる。

## 【0003】

## 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、液晶表示装置の面積を一定として画素数を増やす場合、特にアクティブマトリクス型の液晶表示装置では、画素以外の配線部分やスイッチング素子の部分が占める面積が相対的に大きくなるので、これらの部分を覆い隠すブラックマトリクスの面積が増大する。

## 【0004】

さらに、この場合に問題になるのは、画素と画素との距離、即ち、画素電極と画素電極との間隙が必然的に狭くなるので、ある1つの画素電極に着目すると、隣接する他の画素電極の周縁部から受ける電界の影響によって、ディスクリネーション（液晶分子の転傾）が発生しやすくなる、という点である。ディスクリネーションが発生するのであれば、当該発生部分を、当該配線部分やスイッチング素子の部分とともに、ブラックマトリクスにより覆い隠すことが必要となる。

## 【0005】

このように、液晶表示装置の面積を一定として画素数を増やす場合、配線部分やスイッチング素子の部分のみならず、ディスクリネーションの発生部分についても、ブラックマトリクスにより覆い隠すことが必要となるので、ブラックマト

リクスの面積が表示領域に対して極端に大きくなる。したがって、この場合、表示に寄与する画素開口部の面積が減少して開口率が低下する結果、表示画面が暗くなって、画像品位を低下させる、という問題があった。

#### 【0006】

ここで、ディスクリネーションによる表示欠陥について詳述する。現在の投射表示素子をして用いる液晶表示装置にあって、高精細構造としたものでは、複数マトリクス状に配列する矩形状の画素電極の幅が $20 \times 10^{-6} \text{m}$  ( $20 \mu\text{m}$ ) 角程度に微細化されている。さらに、高精細化された液晶表示装置において、反射型の構造を採用すると、基板上に形成したスイッチング素子を絶縁膜で覆った上に、画素電極をほとんど隙間なく配置することができる。このため、反射型の構造の液晶表示装置では、画素電極同士の間隔を、わずか $1 \times 10^{-6} \text{m}$  ( $1 \mu\text{m}$ ) 程度まで狭めることができるようになってきている。

#### 【0007】

このように画素電極の間隔が狭められた液晶表示装置にあっては、図11に示すように、一方の基板側に設けられる画素電極100、101の間隔Lが $1 \times 10^{-6} \text{m}$ 程度であり、これに対向する基板側に設けられる共通電極102と、画素電極100、102との間隔dが $2 \times 10^{-6} \sim 4 \times 10^{-6} \text{m}$ であるので、相隣接する画素電極100、101間の境界部分に存在する液晶には強い横電界が作用することになる。ここで例えば、共通電極102をアースして0Vに固定し、画素電極100に+5Vを印加し、画素電極101に-5Vを印加して液晶を配向制御する場合、電圧を印加することで基板に対して起立するタイプの液晶を使用すると、図12に示すように、画素電極100に対応する領域の液晶にあって画素電極101に近い側の領域の液晶には、+5Vと-5Vの電位差である10Vの横電界が発生して、この横電界の影響を受けた液晶は、本来とは異なる向きに配向する可能性が高い。即ち、画素電極100で配向制御すべき領域の液晶において、一部の液晶が他の液晶と微妙に異なる方向に向くことになる。この結果、配向方向が微妙に異なる液晶の境界領域（図12に符号DRで示す境界線に沿う領域）にディスクリネーションラインと称される線状の表示欠陥が生じてしまうことになる。なお、この線状の表示欠陥の幅を実際に測定してみたところ、平均

的に  $3 \times 10^{-6} \text{ m}$  ( $\mu \text{ m}$ ) 程度の幅であることが判明した。

【 0 0 0 8 】

ここで、図 1 4 は、従来型の液晶表示装置において、画素部における光の反射状態を計算して、その明度を表したものである。この図に示されるように、画素内の輝度は、ディスクリネーションラインの発生により、特に画素の両サイドにおいて低下していることがわかる。

【 0 0 0 9 】

ところで、ディスクリネーションによる表示欠陥をできるだけ解消するという目的から、相隣接する画素電極の極性をできるだけ同一にすることが可能なフレーム反転駆動方式を採用し、表示の際のフレーム毎に同一極性の電圧を全画素電極に印加して液晶を駆動することにもなされているが、フレーム反転駆動方式では上述のような問題を完全には解消できるものではなかった。即ち、表示領域の全面を白または黒のいずれかの表示とする場合には、フレーム反転駆動が有効ではあるものの、表示領域内に白表示と黒表示とが混在するような表示形態では、白表示と黒表示の境界部分が灰色表示に近い表示となってしまう、境界部分の表示がにじんだ状態となってしまう。例えば、図 1 3 に示すように、白表示の背景に黒表示で「A」の文字を表示しようとした場合、黒表示の「A」の輪郭部分の周囲の白表示部分に、ディスクリネーションラインに起因する灰色表示領域が生成されて、「A」の文字の輪郭が不鮮明となって、コントラストの低い表示形態となってしまう。特に、投射型表示素子では、拡大投射表示ゆえに事態はより深刻となる。

【 0 0 1 0 】

一方、液晶の駆動方式には、フレーム反転駆動方式の外に、縦の 1 ライン毎、あるいは、横の 1 ライン毎に駆動電圧の極性を入れ替えるライン反転駆動方式や、隣接する画素電極毎に駆動電圧の極性を入れ替えるドット反転駆動方式などが知られており、それぞれの駆動方式に長所があるので、プロジェクタ用の液晶パネルにおいて種々の駆動方式を選択できることが望ましい。ただし、前述したディスクリネーションラインが発生する問題から、高精細な液晶パネルの駆動方式として、隣接する画素電極間の電位差が大きくなるライン反転駆動方式や、ドッ

ト反転駆動方式を採用することができないという事情がある。

【0011】

さらに、現在、プロジェクタに要求される性能は、第1に明るさであり、この点は、画素に対応してマイクロレンズを設け、開口部分に光を収束することで、実効開口率を向上させることが可能ではある。ただし、マイクロレンズを設けると、画素に入射する光束密度は大きくなる結果、配向膜が損傷して液晶に配向異常が生じる可能性が指摘されている。なお、以上においては、説明の簡略化のために、液晶表示装置に通常設けられているカラーフィルタや偏光板を除外して、パネル単独での開口率を問題として説明した。

【0012】

本発明は、上述した事情を背景としてなされたものであり、その目的とするところは、配向膜のプレチルト角、さらには、画素電極同士の間隙、液晶層の厚さを特定の関係に規定することにより、液晶の異常配向に起因する表示欠陥の発生を抑制して、明るい表示が可能な液晶装置、投射型表示装置および電子機器の提供を目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明に係る液晶装置にあっては、相対向する面にそれぞれ配向膜が設けられた一对の基板間に液晶が挟持されてなり、複数の走査線と、複数のデータ線と、これら走査線およびデータ線により区画された画素領域毎に設けられたスイッチング素子および画素電極とを有する液晶装置であって、前記配向膜によるプレチルト角が $20^{\circ}$ 以上 $30^{\circ}$ 以下になっていることを特徴としている。この構成によれば、ディスクリネーションに起因する表示欠陥が画素外に置かれるので、ディスクリネーションの発生部分を遮光するためのブラックマトリクスを余計に設けなくて済む結果、その分だけ明るい表示を確保することが可能となる。

【0014】

ここで、本発明において、前記配向膜が酸化シリコンまたは窒化シリコンからなる構成が望ましい。このよう材料から例えば斜方蒸着法を用いて配向膜を形成



すると、 $20^{\circ}$  以上 $30^{\circ}$  以下のプレチルト角を比較的容易に実現でき、さらに、光による配向膜の分解が防止されるので、配向異常の発生を防止することができる。

## 【 0 0 1 5 】

また、本発明において、前記一対の基板間に挟持される液晶層の厚さ（セルギャップ）を $d$ とし、前記画素電極同士の間隙を $L$ としたときに、 $d/L \geq 1$ なる関係を満たすことが望ましい。ディスクリネーションは、セルギャップ $d$ が小さくなるにつれて、また、画素電極同士の間隙 $L$ が狭くなるにつれて、それぞれ顕著に現れるが、このような $d/L \geq 1$ なる関係を満たせば、横電界の影響が少なく、かつ、開口率を大きくとることができる。

## 【 0 0 1 6 】

さらに、本発明では、前記画素電極が光反射性の金属電極である構成としても良い。画素電極が光反射性の金属電極から構成すると、スイッチング素子や配線を画素電極の下層に形成することができる。このため、画素電極をスイッチング素子や配線の配置と関係なく配置することができる。

## 【 0 0 1 7 】

さて、本発明に係る投射型液晶装置は、上記液晶装置を備えているので、ディスクリネーションによる表示欠陥を防止した明るい表示が可能となる。

## 【 0 0 1 8 】

具体的には、光源と、前記光源からの光を変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射レンズとが具備され、前記光変調装置として上記液晶装置が用いられた構成とすると、拡大投射する際に、ディスクリネーションによる表示欠陥を防止した明るい表示が可能となる。

## 【 0 0 1 9 】

同様に、光源と、前記光源からの光を変調する光変調装置と、前記光変調装置により変調された光を投射する投射レンズとが具備され、前記光変調装置として上記液晶装置が青系の表示部に用いられた構成とすると、青色の純度を向上させた表示が可能となる。

## 【 0 0 2 0 】

また、本発明に係る電子機器は、上記液晶装置を備えているので、ディスクリネーションによる表示欠陥を防止した明るい表示が可能となる。

#### 【0021】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明するが、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。

#### 【0022】

##### <液晶装置の画素部>

まず、本発明の第1実施形態に係る液晶装置について説明する。まず、この液晶表示装置の画素部について、図1および図2を参照して説明する。図1は、液晶装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子や、配線などの等価回路である。図2は、図1に示したTFT1個に係るTFTアレイ基板を拡大して示す拡大断面図である。尚、断面図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。

#### 【0023】

さて、図1において、本実施形態による液晶装置の画像表示領域においては、m本の走査線3aが行方向に延在する一方、n本のデータ線6aが列方向に延在するとともに、これらの走査線3aとデータ線6aとの交差部分に対応して、TFT30と画素電極9aとが、マトリクス状に配列している。ここで、TFT30のゲート電極は走査線3aに接続され、そのソース電極はデータ線6aに接続され、そのドレイン電極は画素電極9aに接続されている。また、m本の走査線3aの各々には、所定のタイミングで順番にアクティブレベルとなる走査信号G1、G2、…、Gmがそれぞれ印加される構成となっており、また、n本のデータ線6aの各々には、ある走査信号がアクティブレベルとなる期間に、画像信号S1、S2、…、Snが、この順番で線順次に、または、相隣接する複数のデータ線6a同士のグループ毎に、それぞれ供給される構成となっている。

#### 【0024】

したがって、ある走査信号がアクティブレベルになると、当該走査信号が供給

される走査線 3 a の 1 行分の T F T 3 0 は一斉にオンすることになる。そして、このオン期間に、供給される画像信号 S 1、S 2、…、S n が、当該 1 行分の画素電極 9 a の各々に書き込まれて、後述する対向基板に形成された対向電極との間で一定期間保持されることになる。

#### 【 0 0 2 5 】

ここで、液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、ここを通過する光を変調し、階調表示を可能にする。液晶がノーマリーホワイトモードであれば、印加された電圧に応じて入射光がこの液晶部分を通す不可能とされ、ノーマリーブラックモードであれば、印加された電圧に応じて入射光が液晶部分を通す可能とされて、全体として液晶装置からは画像信号に応じた強度を持つ光が出射する。ここで、保持された画像信号がリークするのを防ぐために、画素電極 9 a と対向電極との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量 7 0 が付加されている。この蓄積容量 7 0 により、画素電極 9 a の電圧を、ソース電圧が印加された時間よりも 3 桁程度長い時間保持できるので、保持特性が改善されて、コントラスト比の高い液晶装置が実現できる。

#### 【 0 0 2 6 】

次に、図 2 の拡大断面図に示すように、T F T アレイ基板 1 0 には、各画素電極 9 a に隣接する位置に、画素スイッチング用 T F T (スイッチング素子) 3 0 が設けられている。一方、画素電極 9 a において T F T 3 0 とは反対側には配向膜 1 6 が設けられている。なお、T F T アレイ基板 1 0 は、後述するように対向電極や配向膜が形成された対向基板と一定の間隙を保って貼り合わせられ、この間隙に液晶が封入されて、液晶層 5 0 が形成されている。また、この液晶層 5 0 は、画素電極 9 a と対向電極とに電圧差がない状態で、両基板に形成された配向膜により所定の配向状態となるように構成されている。

#### 【 0 0 2 7 】

さて、T F T アレイ基板 1 0 には、画素スイッチング用 T F T 3 0 に対向する位置に第 1 遮光膜 1 1 a が設けられている。第 1 遮光膜 1 1 a は、好ましくは不透明な高融点金属である T i や、C r、W、T a、M o 及び P d のうちの少なくとも一つを含む金属単体、合金、金属シリサイド等から構成されている。このよ

うな材料から第1遮光膜11aを構成すれば、後に行われる高温処理により、第1遮光膜11aが破壊されたり溶融したりしないようにできる。また、第1遮光膜11aにより、TFTアレイ基板10の側からの戻り光等が画素スイッチング用TFT30のチャネル領域1a'やLDD領域1b、1cに入射する事態を未然に防ぐことができ、光電流の発生により画素スイッチング用TFT30の特性が劣化することを防止できる。

## 【0028】

次に、第1遮光膜11aと複数の画素スイッチング用TFT30との間には、第1層間絶縁膜12が設けられている。第1層間絶縁膜12は、画素スイッチング用TFT30を構成する半導体層1aを、第1遮光膜11aから電氣的に絶縁するために設けられるものである。更に、第1層間絶縁膜12は、TFTアレイ基板10の全面に形成されることにより、画素スイッチング用TFT30のための下地膜としての機能をも有する。即ち、TFTアレイ基板10の表面の研磨時における荒れや、洗浄後に残る汚れ等で画素スイッチング用TFT30の特性の劣化を防止する機能を有する。ここで、第1層間絶縁膜12は、例えば、NSG（ノンドープトシリケートカラズ）や、PSG（リンシリケートガラス）、BSG（ボロンシリケートガラス）、BPSG（ボロンリンシリケートガラス）などの高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜等からなる。このような第1層間絶縁膜12により、第1遮光膜11aが画素スイッチング用TFT30等を汚染する事態を未然に防ぐこともできる。なお、TFTアレイ基板10に不透明なSi基板を用いた場合、第1遮光膜11aは不要となる。

## 【0029】

続いて、画素スイッチング用TFT30を構成する半導体層1aの表面には、熱酸化処理等によるゲート絶縁膜2が形成され、さらに、ポリシリコン膜からなる走査線3aが形成されている。このため、走査線3aのうち、半導体層1aと交差する部分がTFT30のゲート電極として機能し、また、半導体層1aのうち、当該走査線3aの直下の部分がチャネル領域1a'として機能することになる。さらに、半導体層1aのうち、チャネル領域1a'に隣接する両側には、それぞれ低濃度ソース領域（ソース側LDD領域）1b、同低濃度ドレイン領域（

ドレイン側 LDD 領域) 1 c が設けられ、さらに外側には、それぞれ高濃度ソース領域 1 d、高濃度ドレイン領域 1 e が設けられて、TFT 3 0 は、いわゆる LDD (Lightly Doped Drain) 構造を有している。なお、各領域 1 b、1 c、1 d、1 e は、半導体層 1 a に対し、n 型又は p 型のチャネルを形成するかに応じて所定濃度の n 型用又は p 型用のドーパントをドーピングすることにより形成されている。なお、n 型チャネルの TFT は、動作速度が速いという利点があり、画素のスイッチング素子である画素スイッチング用 TFT 3 0 として用いられることが多い。

#### 【0030】

また、画素電極 9 a の材料には、透過型であれば、ITO (Indium Tin Oxide) のような透明導電膜が望ましく、一方、反射型であれば、Al 又は Ag などの反射性の高い導電膜で形成すれば良い。

#### 【0031】

さて、TFT 3 0 を構成する半導体層 1 a のうち、高濃度ソース領域 1 d は、ゲート絶縁膜 2 および第 2 層間絶縁膜 4 を開孔するコンタクトホール 5 によって、Al 等の低抵抗な金属膜や金属シリサイド等の合金膜などの遮光性薄膜からなるデータ線 6 a に接続される一方、高濃度ドレイン領域 1 e は、ゲート絶縁膜 2、第 2 層間絶縁膜 4 および第 3 層間絶縁膜 7 を開孔するコンタクトホール 8 によって対応する画素電極 9 a に接続されている。なお、高濃度ドレイン領域 1 e と画素電極 9 a とは、データ線 6 a と同一の Al 膜や走査線 3 a と同一のポリシリコン膜を中継して電氣的に接続するようにしてもよい。

#### 【0032】

なお、TFT 3 0 は、上述のように LDD 構造を持つのが好ましいが、低濃度ソース領域 1 b 及び低濃度ドレイン領域 1 c に不純物イオンの打ち込みを行わないオフセット構造を持ってよいし、ゲート電極 3 a をマスクとして高濃度で不純物イオンを打ち込み、自己整合的に高濃度ソース及びドレイン領域を形成するセルフアライン型の TFT であってもよい。

#### 【0033】

一方、TFT 3 0 の半導体層 3 a のうち、高濃度ドレイン領域 1 e に隣接する

高濃度領域 1 f は、走査線 3 a と略平行に延在する容量線 3 b の形成位置まで延設されているとともに低抵抗化されている。このため、蓄積容量 7 0 は、高濃度領域 1 f と容量線 3 b の一部とによってゲート絶縁膜 2 を誘電体として挟持した構成となっている。ここで、蓄積容量 7 0 の誘電体は、高温酸化によりポリシリコン膜上に形成される T F T 3 0 のゲート絶縁膜 2 に他ならないので、薄く且つ高耐圧の絶縁膜とすることができる。このため、蓄積容量 7 0 は、比較的小面積で大容量とすることができる。

## 【 0 0 3 4 】

この結果、データ線 6 a 下の領域及び走査線 3 a に沿うスペースという開口領域を外れたスペースを有効に利用して、画素電極 9 a の蓄積容量を増やすことが出来る。なお、画素電極 9 a をデータ線 6 a や走査線 3 a 上に絶縁膜を介して形成しても構わない。

## 【 0 0 3 5 】

なお、本実施形態では、画素スイッチング用 T F T 3 0 のゲート電極（データ線 3 a ）をソースドレイン領域 1 b 及び 1 e 間に 1 個のみ配置したシングルゲート構造としたが、これらの間に 2 個以上のゲート電極を配置してもよい。この際、各々のゲート電極には同一の信号が印加されるようにする。このようにデュアルゲート（ダブルゲート）或いはトリプルゲート以上で T F T を構成すれば、チャンネルとソースドレイン領域接合部のリーク電流を防止でき、オフ時の電流を低減することができる。これらのゲート電極の少なくとも 1 個を L D D 構造或いはオフセット構造にすれば、更にオフ電流を低減でき、安定したスイッチング素子を得ることができる。

## 【 0 0 3 6 】

次に、上述した構造の液晶表示装置において、配向膜による液晶のプレチルト角、画素電極 9 a の間隙、および、液晶層の厚さの関係について検討する。まず、説明の便宜のため、図 3 に示すように、画素電極 9 a の本体部 9 a 1 同士の間隙を  $L$  ( $\times 10^{-6} \text{ m}$ ) とし、画素電極 9 a の配列ピッチを  $P$  ( $\times 10^{-6} \text{ m}$ ) とし、さらに、液晶層の厚さ（基板 1 0 側の配向膜 1 6 と基板 2 0 側の配向膜 2 2 との間隔であるセルギャップ）を  $d$  ( $\times 10^{-6} \text{ m}$ ) とする。また、液晶分子の

長軸と基板（配向膜）面とのなす角度（プレチルト角）を  $\theta_p$  とする。

【0037】

まず、図1および図2の構成において、配列ピッチ  $P$  を  $25 \times 10^{-6} \text{m}$  とし、画素電極 9a を  $15 \times 10^{-6} \text{m}$  角の大きさとした（したがって、間隙  $L$  は  $10 \times 10^{-6} \text{m}$  である）。また、セルギャップ  $d$  を  $5 \times 10^{-6} \text{m}$  に設定した、さらに、配向膜 16、22 に無機材料である  $\text{SiO}_2$  を用い、斜方蒸着法によって、プレチルト角  $\theta_p$  が  $25^\circ$  となるように設定するとともに、両基板間で  $45^\circ$  のツイストネマティック配向モードとした。この際、ネガ型のネマティック液晶の屈折異方性  $\Delta n$  とセルギャップ  $d$  との積  $\Delta n \cdot d$  の値を  $0.48 \times 10^{-6} \text{m}$  とした。

【0038】

さらに、図示省略するが、対向基板 20 には、基板背面（上側）において、感光性樹脂からなるマイクロレンズと、マイクロレンズを覆うアクリル系接着層と、カバーガラスとが形成されている。

【0039】

このような条件下において、相隣接する画素電極からの横電界の影響を考慮しつつ、液晶配向状態を計算して、光の反射率が画素電極においてどのような明度となるかをシミュレートした結果を、図8に示す。この図では、図14に示す従来例と比較して明らかにディスクリネーションに起因する表示欠陥が低減していることが判る。

【0040】

続いて、プレチルト角  $\theta_p$  を変化させた場合に、 $\Delta n \cdot d$  を  $0.48 \mu\text{m}$  に固定したとき、必要となるセルギャップ  $d$  の計算結果を、次表（表1）に示す。なお、この表には、駆動方式としてドット反転駆動方式を採用した場合の反射率、および、その応答速度の計算結果についても併せて示す。

【0041】

【表 1】

プレチルト角 (度)	0	5	10	20	30	40	50
$\Delta n$	0.15	0.148	0.145	0.13	0.108	0.08	0.057
セル厚	3.2	3.24	3.31	3.7	4.4	6	8.4
反射率 (%)	42	44	45	56	60	62	63
応答時間(ms)	46	47	50	62.7	72	165	324

## 【0042】

この表 1 からプレチルト角  $\theta_p$  が  $30^\circ$  以上では、セルギャップ  $d$  が大きくなる  
ことがわかる。また、応答時間はセルギャップ  $d$  の 2 乗に比例して大きくなるこ  
とが知られているので、セルギャップ  $d$  が大きくなる方向は好ましくない。また  
、プレチルト角  $\theta_p$  が  $20^\circ$  以下では、反射率が減少しているが、これは、ディス  
クリネーションが発生しているためである。よって、プレチルト角  $\theta_p$  を、 $20^\circ$   
以上  $30^\circ$  以下に設定するのが望ましいと、考える。

## 【0043】

上述したように、横電界の影響は、セルギャップ  $d$  が小さいほど受けやすく、  
また画素電極同士の間隙  $L$  が狭いほど受けやすいので、高精細のパネルであれば  
、顕著に現れることになる。また、表 1 で述べたようにセルギャップ  $d$  が大きく  
なると、応答時間が大きくなるが、明るさに関しては、 $\Delta n \cdot d$  を一定とする場  
合に、セルギャップ  $d$  を小さくすると、 $\Delta n$  の大きな液晶材料が必要となる。た  
だし、 $\Delta n$  の大きな液晶には、信頼性のあるものが少ないため、プロセス上不利  
である。

## 【0044】

次に、画素電極 9a の配列ピッチ  $P$  を  $10\mu m$  で、かつ、セルギャップ  $d$  を  $3$   
、 $2\mu m$  で一定とした場合に、画素電極同士の間隙  $L$  を変化させたときの、開口  
率の変化について次表 (表 2) に示す。

## 【0045】



【表 2】

L (μm)	1	2	3	4
d (μm)	3.2	3.2	3.2	3.2
d/L	3.2	1.6	1.06	0.8
開口率 (%)	90	80	70	60

## 【0046】

ここで、プレチルト角  $\theta_p$  を、 $20^\circ$  以上  $30^\circ$  以下に設定する場合に、横電界の影響が少なく、かつ、開口率を大きくとるためには、セルギャップ  $d$  と間隙  $L$  との間に、 $d/L \geq 1$  なる関係が必要であることが判る。

## 【0047】

したがって、プレチルト角  $\theta_p$  を、 $20^\circ$  以上  $30^\circ$  以下に設定するとともに、セルギャップ  $d$  と間隙  $L$  との間に、 $d/L \geq 1$  なる関係を満たすようにすれば、隣接する他の画素電極による横電界の影響を受けてもディスクリネーションラインが画素内に生じるおそれが少なくなって、高精細な表示構成であってもコントラスト比の高く高品位な表示が可能となる。

## 【0048】

## ＜液晶装置の全体構成＞

次に、本実施形態に係る液晶装置の全体構成を図4および図5を参照して説明する。図4において、TFTアレイ基板10の上には、シール材52がその縁に沿って設けられ、その内側に並行して、周辺見切りとしての遮光膜53が設けられている。シール材52の外側の領域には、データ線駆動回路101及び実装端子102がTFTアレイ基板10の一辺に沿って設けられており、走査線駆動回路104が、この一辺に隣接する2辺に沿って設けられている。走査線3aに供給される走査信号の遅延が問題にならないのならば、走査線駆動回路104は片側だけでも良いことは言うまでもない。また、データ線駆動回路101を画像表示領域の辺に沿って両側に配列してもよい。更に、TFTアレイ基板10の残る一辺には、画像表示領域の両側に設けられた走査線駆動回路104の間をつなぐ

ための複数の配線 1 0 5 が設けられている。そして、図 5 に示すように、シール材 5 2 とほぼ同じ輪郭を持つ対向基板 2 0 が当該シール材 5 2 によって一定のギャップ  $d$  を保って T F T アレイ基板 1 0 に固着されるとともに、この空間に液晶が封入され、液晶層 5 0 が形成される。なお、シール材 5 2 は、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂などからなる接着剤であり、この中には、棒状や球形のスペーサ（図面では省略した）が混入されて、一定のギャップ  $d$  が保たれる構成となっている。

## 【 0 0 4 9 】

また、対向基板 2 0 の投射光が入射する側及び T F T アレイ基板 1 0 の出射光が出射する側には各々、例えば、T N（ツイステッドネマティック）モードのほか、S T N（スーパー T N）モード、強誘電性液晶（F L C）モード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード／ノーマリーブラックモードの別に応じて、偏光フィルム、位相差フィルム、偏光板などが所定の方角で適宜配置される。

## 【 0 0 5 0 】

以上説明した実施形態に係る液晶装置は、カラー液晶プロジェクタに適用されるため、3 枚の液晶装置が R G B 用のライトバルブとして各々用いられるとともに、各液晶装置には、後述するように各々 R G B 色分解用のダイクロイックミラーを介して分解された各色の光が投射光として各々入射されることになる。

## 【 0 0 5 1 】

従って、本実施の形態では、対向基板 2 0 側に、カラーフィルタは設けられていない。しかしながら、対向基板 2 0 にあって、画素電極 9 a に対向する領域に R G B のカラーフィルタをその保護膜と共に形成してもよい。このようにすれば、液晶プロジェクタ以外の直視型や反射型のカラー液晶テレビなどのカラー液晶装置に各実施の形態における液晶装置を適用できる。更にまた、対向基板 2 0 上に、何層もの屈折率の相違する干渉層を堆積することで、光の干渉を利用して、R G B 色を作り出すダイクロイックフィルタを形成してもよい。このダイクロイックフィルタ付き対向基板によれば、より明るいカラー液晶装置が実現できる。

## 【 0 0 5 2 】

また、各画素に設けられるスイッチング素子としては、正スタガ型又はコブラ

ナー型のポリシリコン T F T であるとして説明したが、逆スタガ型の T F T やアモルファスシリコン T F T 等などの、他の型の T F T に対しても、実施形態は有効である。

#### 【 0 0 5 3 】

尚、本実施の形態では、T F T を用いて画素電極 9 a を駆動するように構成したが、T F T 以外の、例えば、T F D (Thin Film Diode: 薄膜ダイオード) 等のアクティブマトリクス素子を用いることも可能であり、更に、液晶装置をパッシブマトリクス型の液晶装置として構成することも可能である。

#### 【 0 0 5 4 】

図 6 は、本実施形態の液晶装置を駆動する場合に適用できる駆動方式について説明するためのものである。第 1 に、図 6 ( a ) に示すように枠線で囲んだ区形状の領域を 1 つの画素と見立てると、全部の画素についてフレーム毎に同一極性の電圧で駆動する方式、換言すると、図 6 ( a ) に示すフレームでは + の電位を全画素に印加し、図示しない他のフレームでは - の電位を全画素に印加する、という電圧印加をフレーム毎に繰り返し行うフレーム反転駆動方式を採用できる。第 2 に、図 6 ( b ) に示すように上下左右に隣接する画素の 1 つ 1 つで互いに極性が異なる電圧を印加して駆動するドット反転駆動方式を採用することができる。第 3 に、図 6 ( c ) に示すように横の 1 ライン毎に印加する電位を逆極性とするか、図 6 ( d ) に示すように縦の 1 ライン毎に印加する電位を逆極性とするライン反転駆動方式を採用することができる。

#### 【 0 0 5 5 】

ここで、従来の高精細の液晶装置において、複数の画素電極の間隔を  $1 \times 10^{-6}$  m 程度に狭めた構造では、横電界の影響でフレーム反転駆動方式しか採用できない。これは、ドット反転駆動あるいはフレーム反転駆動を行うと、ディスクリネーションラインを生じて表示欠陥が発生するおそれがあるからである。これに対し、本実施形態の構造を採用すると、隣接する画素の間で印加電圧の極性が異なるような駆動方式を採用しても、表示領域にディスクリネーションラインを生じるおそれが少なくなるので、図 6 ( b ) に示すドット反転駆動方式や、同図 ( c ) または同図 ( d ) に示すライン反転駆動方式を採用しても、ディスクリネー

ションの発生を抑えることができる。従って、本実施形態では、いずれの駆動方式でも適用することができるので、汎用性を高めることができる。

【 0 0 5 6 】

<第 2 実施形態>

次に、本発明の第 2 実施形態に係る液晶装置について説明する。この液晶装置は、第 1 実施形態における T F T アレイ基板 1 0 を半導体基板とするとともに、この半導体基板に画素スイッチング用の能動素子を作り込んだものである。この際、半導体基板は光の透過性を有しないので、液晶装置は反射型として用いられる。

【 0 0 5 7 】

図 7 は、同実施形態に係る反射型液晶装置において、画素スイッチング用の電界効果トランジスタ 1 個分の構成を示す断面図である。なお、等価回路的には、図 1 に示した第 1 実施形態と何ら代わるところはない。

【 0 0 5 8 】

さて、図において、符号 1 0 1 は、単結晶シリコンのような P 型あるいは N 型の半導体基板であり、符号 1 0 2 は、半導体基板 1 0 1 の表面に形成されて、基板より不純物濃度の高い P 型あるいは N 型のウェル領域である。ウェル領域 1 0 2 は、特には限定されないが、例えば、縦 7 6 8 個×横 1 0 2 4 個あるいはそれ以上の画素を有するような高精細な液晶パネルの場合、それらの画素のウェル領域を共通ウェル領域として形成されるが、他のデータ線駆動回路や走査線駆動回路、入力回路、タイミング回路等の周辺回路を構成する素子が形成される部分のウェル領域とは分離して形成されることもある。

【 0 0 5 9 】

次に、符号 1 0 3 は、半導体基板 1 0 1 の表面に形成された素子分離用のフィールド酸化膜（いわゆる L O C O S）である。フィールド酸化膜 1 0 3 は、例えば選択熱酸化によって形成される。フィールド酸化膜 1 0 3 には、開口部が形成され、この開口部の内側中央にシリコン基板表面の熱酸化により形成されるゲート酸化膜 1 1 4 を介して、ポリシリコンまたはメタルシリサイド等からなるゲート電極 1 0 5 a 及び走査線が形成され、ゲート電極 1 0 5 a の両側にあって基板

表面側にはウェル領域102より高不純物濃度のN型不純物層（ドーピング層）からなるソース領域106a、ドレイン領域106bが形成され、これらにより電界効果トランジスタ（FET：スイッチング素子）105が構成されている。

#### 【0060】

上記ソース領域106a、ドレイン領域106bの上方には、BPSG（Boron Phosphorus Silica Glass）膜のような第1層間絶縁膜104を介して、1層目のアルミニウム層からなる第1の導電層107a、107bが形成される。このうち、第1の導電層107aは、第1層間絶縁膜104に形成されたコンタクトホールを介してソース領域106aと電氣的に接続され、データ信号の電圧をソース領域106aに供給するソース電極（データ線に相当する）を構成する。また、第1導電層107bは、第1層間絶縁膜104に形成されたドレイン電極を構成する。

#### 【0061】

次に、上記第1の導電層107a、107bの上には二酸化シリコンのような絶縁膜からなる第2層間絶縁膜108が形成され、さらにその上方にはアルミニウム層あるいはタンタル層からなる第2の導電層109が形成されている。

#### 【0062】

さらに、第2の導電層109の上方には、二酸化シリコンや、窒化シリコン、酸化タンタル等の高誘電率の材料からなる絶縁層110が形成され、その上にドレイン電極107bに接続された光反射性の金属からなる画素電極112が形成されている。このような画素電極112は、第2の導電層109とともに絶縁層110を挟持している。したがって、ここに、保持容量113が構成されることになる。このため第2の導電層109は、その表面が平坦化されていることが望ましい。なお、第2の導電層109には、液晶パネルにおける共通電位電極Vcomあるいはその近傍、又は上記画素電極（反射電極）112に印加された電圧（データ信号電圧）の振幅の中心電位あるいはその近傍、又は上記の共通電極電位と上記の電圧振幅中心電圧の中間の電位、のいずれかの所定の電位を与える配線が電氣的に接続されている。なお、共通電極電位Vcomとは液晶層を極性反転駆動する際の反転中心電位に相当する。

## 【 0 0 6 3 】

そして、図 7 に示す画素電極 1 2 は、平面的には、第 1 実施形態と同様にマトリクス状に配置され、これらの画素電極 1 1 2 上に図面では省略した配向膜が形成されるとともに、半導体基板 1 0 1 と対向する側には、第 1 実施形態と同様な対向基板が配置され、さらに、両基板間に液晶層が挟持されてなり、反射型の液晶表示装置が構成されることとなる。

## 【 0 0 6 4 】

この第 2 実施形態に係る液晶表示装置の半導体基板 1 0 1 においても先の実施形態の構造と同様に、プレチルト角  $\theta_p$  を、 $20^\circ$  以上  $30^\circ$  以下に設定するとともに、セルギャップ  $d$  と間隙  $L$  との間に、 $d/L \geq 1$  なる関係を満たすようにすれば、隣接する他の画素電極による横電界の影響を受けてもディスクリネーションラインが画素内に生じるおそれが少なくなって、高精細な表示構成であってもコントラスト比の高く高品位な表示が可能となる。

## 【 0 0 6 5 】

## &lt; プロジェクタ &gt;

次に、上述した実施形態の液晶装置を用いた応用例のいくつかについて説明する。まず、液晶装置をライトバルブに用いた投射型表示装置（液晶プロジェクタ）について説明する。図 9 は、この液晶プロジェクタの構成を示す図である。

## 【 0 0 6 6 】

この液晶プロジェクタは、システム光軸  $L$  に沿って配置した光源部 7 1 0 と、インテグレートレンズ 7 2 0 と、偏光変換素子 7 3 0 から概略構成される偏光照明装置 7 0 0 と、この偏光照明装置 7 0 0 から出射された S 偏光光束を、S 偏光光束反射面 7 4 1 により反射させる偏光ビームスプリッタ 7 4 0 と、偏光ビームスプリッタ 7 4 0 の S 偏光光束反射面 7 4 1 から反射された光のうち、青色光（B）の成分を分離するダイクロックミラー 7 4 2 と、分離された青色光（B）を変調する反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 B と、青色光が分離された後の光束のうち、赤色光（R）の成分を反射させて分離するダイクロックミラー 7 4 3 と、分離された赤色光（R）を変調する反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 R と、ダイクロックミラー 7 4 3 を通過する残りの光の緑色光（G）を変調する反射型液晶ライ

トバルブ 7 4 5 G と、3 つの反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 R、7 4 5 G、7 4 5 B にて変調された光をダイクロックミラー 7 4 3、7 4 2、偏光ビームスプリッタ 7 4 0 にて合成し、この合成光をスクリーン 7 6 0 に投写する投写光学系 7 5 0 とから構成されている。ここで、3 つの反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 R、7 4 5 G、7 4 5 B には、それぞれ実施形態に係る反射型の液晶表示装置（液晶パネル）が用いられている。

## 【 0 0 6 7 】

この構成において、光源部 7 1 0 から出射されたランダムな偏光光束は、インテグレートレンズ 7 2 0 により複数の中間光束に分割された後、第 2 のインテグレートレンズを光入射側に有する偏光変換素子 7 2 0 により偏光光束がほぼ揃った種類の偏光光束（S 偏光光束）に変換されてから偏光ビームスプリッタ 7 4 0 に至るようになっている。偏光変換素子 7 3 0 から出射された S 偏光光束は、偏光ビームスプリッタ 7 4 0 の S 偏光光束反射面 7 4 1 によって反射され、反射された光束のうち、青色光（B）の光束がダイクロックミラー 7 4 2 の青色光反射層にて反射され、反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 B によって変調される。また、ダイクロックミラー 7 4 2 の青色光反射層を透過した光束のうち、赤色光（R）の光束はダイクロックミラー 7 4 3 の赤色光反射層にて反射され、反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 R によって変調される。一方、ダイクロックミラー 7 4 3 の赤色光反射層を透過した緑色光（G）の光束は反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 G により変調される。以上のようにして反射型液晶ライトバルブ 7 4 5 R、7 4 5 G、7 4 5 B によって色光の変調がなされる。

## 【 0 0 6 8 】

これらの液晶パネルの画素から反射された色光のうち、S 偏光成分は S 偏光を反射する偏光ビームスプリッタ 7 4 0 を通過せず、P 偏光成分は通過する。この偏光ビームスプリッタ 7 4 0 を透過した光により画像が形成される。従って、投写される画像は、TN 型液晶を液晶パネルに用いた場合は、OFF 画素の反射光が投写光学系 7 5 0 に至り、ON 画素の反射光レンズに至らないので、ノーマリーホワイト表示となる。

## 【 0 0 6 9 】

また、実施形態に係る液晶表示装置を特に青色系のライトバルブ 7 4 5 B に用いて、青光のカットオフ波長を 4 0 0 n m にすると、色純度をあげた表示が可能となる。

## 【 0 0 7 0 】

反射型液晶パネルは、ガラス基板に T F T アレイを形成したタイプと比較して半導体技術を利用して画素を形成するので、画素数をより多く形成でき、パネルサイズも小さくできるので、高精細な画像を投射できるとともに、プロジェクタ自体の小型化に寄与する。

## 【 0 0 7 1 】

## &lt; 電子機器 &gt;

次に、実施形態に係る液晶表示装置のいずれかを備えた電子機器の具体例について説明する。図 1 0 ( a ) は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図 1 0 ( a ) において、符号 1 0 0 0 は携帯電話本体であり、符号 1 0 0 1 は実施形態に係る液晶表示装置を用いた液晶表示部である。

## 【 0 0 7 2 】

また、図 1 0 ( b ) は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図 1 0 ( b ) において、符号 1 1 0 0 は時計本体であり、符号 1 1 0 1 は実施形態に係る液晶表示装置のいずれかを用了液晶表示部である。

## 【 0 0 7 3 】

図 1 0 ( c ) は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図 1 0 ( c ) において、符号 1 2 0 0 は情報処理装置であり、符号 1 2 0 2 は、キーボードなどの入力部であり、符号 1 2 0 4 は情報処理装置本体であり、符号 1 2 0 6 は実施形態に係る液晶表示装置を用いた液晶表示部である。

## 【 0 0 7 4 】

これらの電子機器は、それぞれ、第 1 または第 2 実施形態に係る液晶表示装置を液晶表示部として備えたので、高コントラスト比で高精細な表示を得ることができる。

## 【 0 0 7 5 】



【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、液晶の異常配向に起因する表示欠陥の発生を抑制して、明るい表示を得ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 実施形態に係る液晶装置にあって、T F T アレイ基板の表示領域の構成を示す等価回路である。

【図 2】 同 T F T アレイ基板における T F T 1 個分の構成を示す拡大断面図である。

【図 3】 同液晶装置の画素ピッチと画素電極間隔と液晶層厚との関係を説明するための概略説明図である。

【図 4】 同液晶装置の全体構成を示す図である。

【図 5】 図 4 の H - H' 線に沿う断面図である。

【図 6】 ( a ) ~ ( d ) は、それぞれ同液晶装置に適用可能な駆動方式の画素毎の電圧分布を示す図である。

【図 7】 同液晶装置に、基板として S i 基板を用いた場合の構成を示す断面図である。

【図 8】 同液晶装置において、光の反射状態を計算して明度を示す図である。

【図 9】 本発明に係る液晶装置を備えた液晶プロジェクタの一実施形態を示す構成図である。

【図 1 0】 ( a ) は携帯電話を示す斜視図であり、( b ) は腕時計を示す斜視図であり、( c ) は携帯型情報処理装置を示す斜視図である。

【図 1 1】 従来の液晶装置に備えられる素子基板側の画素電極と対向基板側の共通電極との位置関係を示すための図である。

【図 1 2】 従来の液晶装置において横電界の影響により液晶の配向状態にディスクリネーションを生じた状態を示す図である。

【図 1 3】 従来の液晶装置において白表示に黒表示で「A」の文字を表示した状態を示す図である。

【図 1 4】 従来の液晶装置において横電界の影響で液晶配向にディスクリ

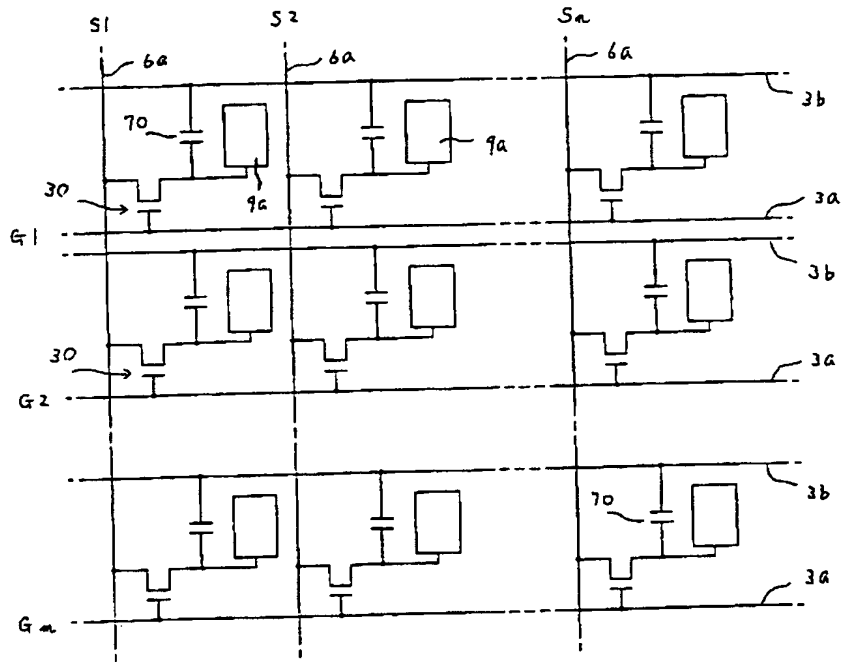
ネーションを生じた配向状態での光の反射を計算して、明度を示す図である。

【符号の説明】

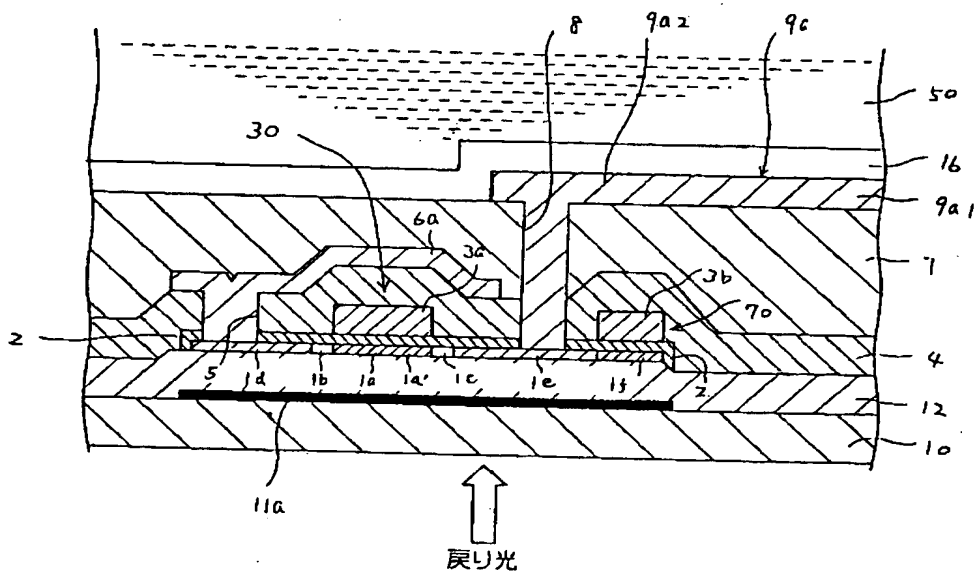
- 8 …コンタクトホール
- 9 a …画素電極
- 1 0 …基板
- 1 6 …絶縁層
- 2 0 …第 2 基板
- 3 0 …T F T
- 5 0 …液晶層
- 1 0 1 …半導体基板
- 1 0 5 …電界効果トランジスタ
- 1 1 2 …画素電極
- 7 0 0 …投射型表示装置
- 1 0 0 0 …携帯電話
- 1 1 0 0 …腕時計
- 1 2 0 0 …情報処理装置

【書類名】 図面

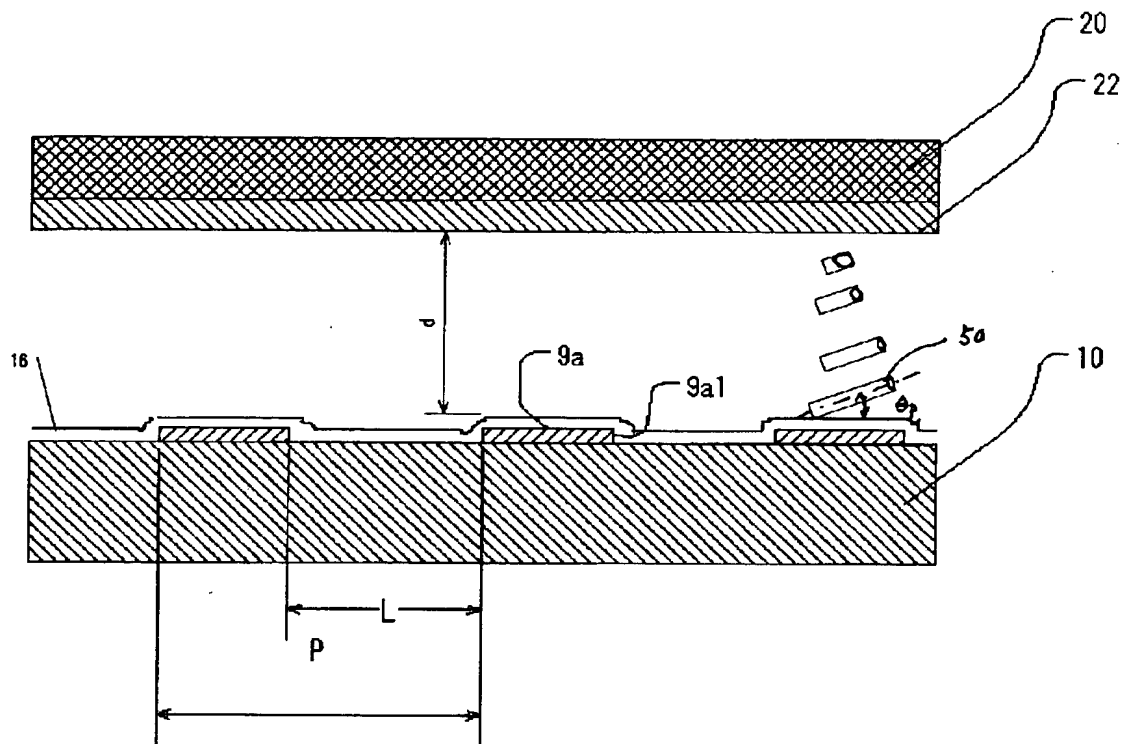
【図 1】



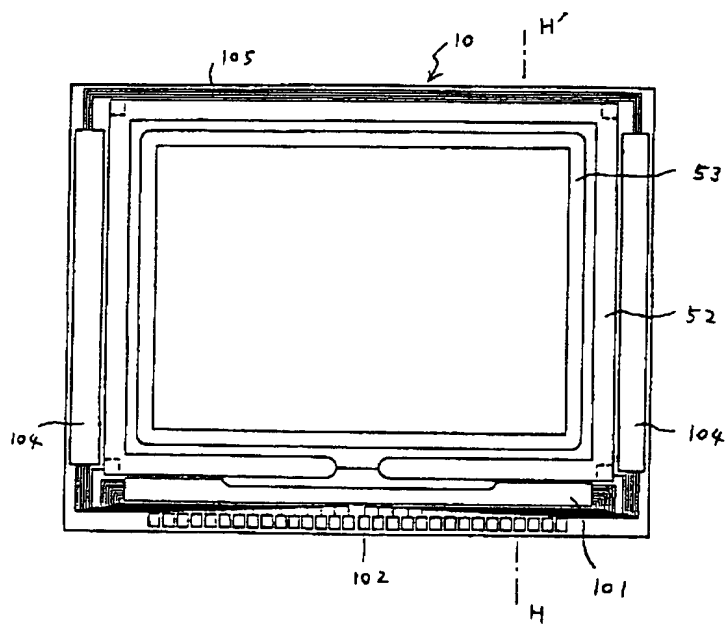
【図 2】



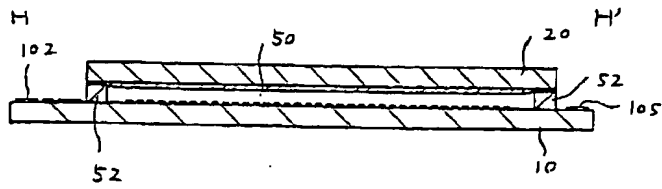
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【図 6】

(a) フレーム反転

+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+

(b) ドット反転

+	-	+	-	+	-	+	-
-	+	-	+	-	+	-	+
+	-	+	-	+	-	+	-
-	+	-	+	-	+	-	+
+	-	+	-	+	-	+	-
-	+	-	+	-	+	-	+
+	-	+	-	+	-	+	-
-	+	-	+	-	+	-	+
+	-	+	-	+	-	+	-
-	+	-	+	-	+	-	+

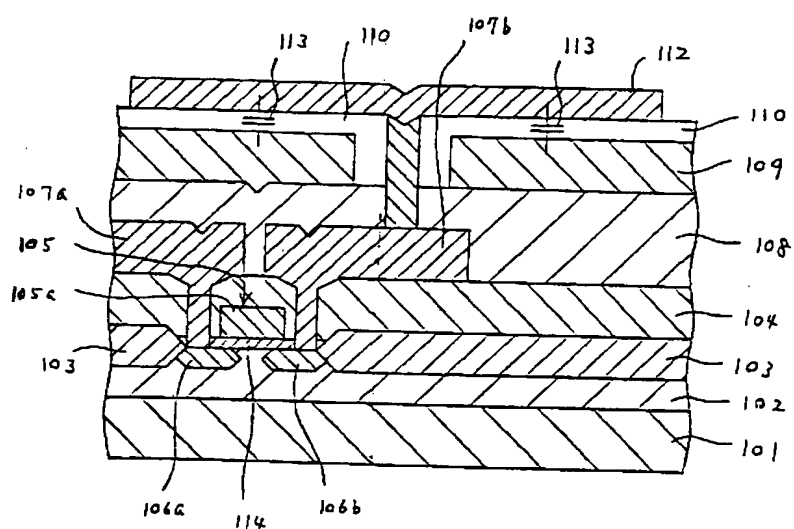
(c) ライン反転

+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-

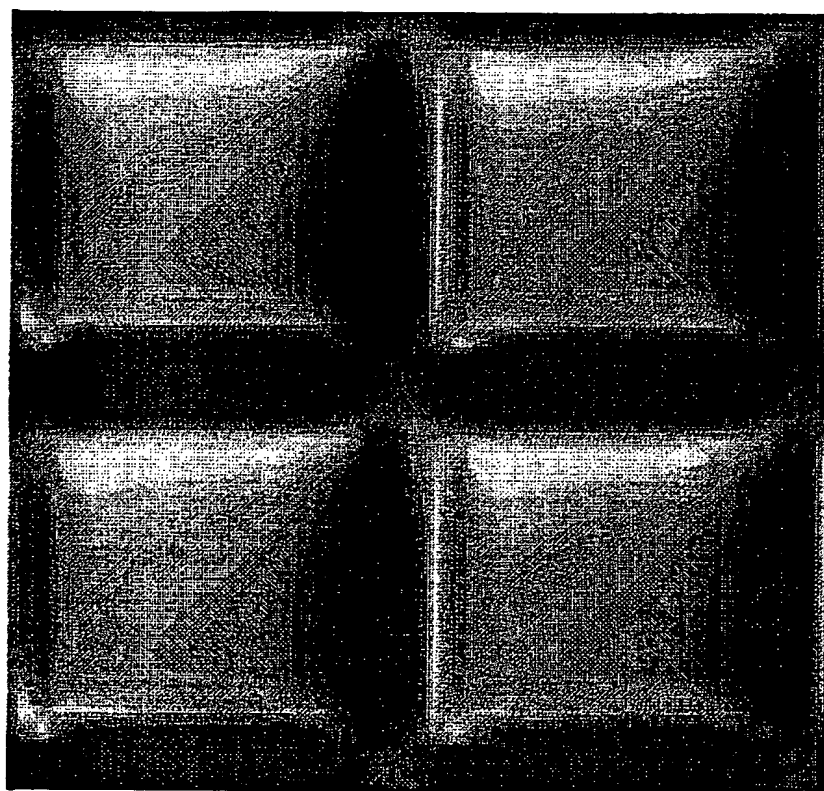
(d) ライン反転

+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-
+	-	+	-	+	-	+	-

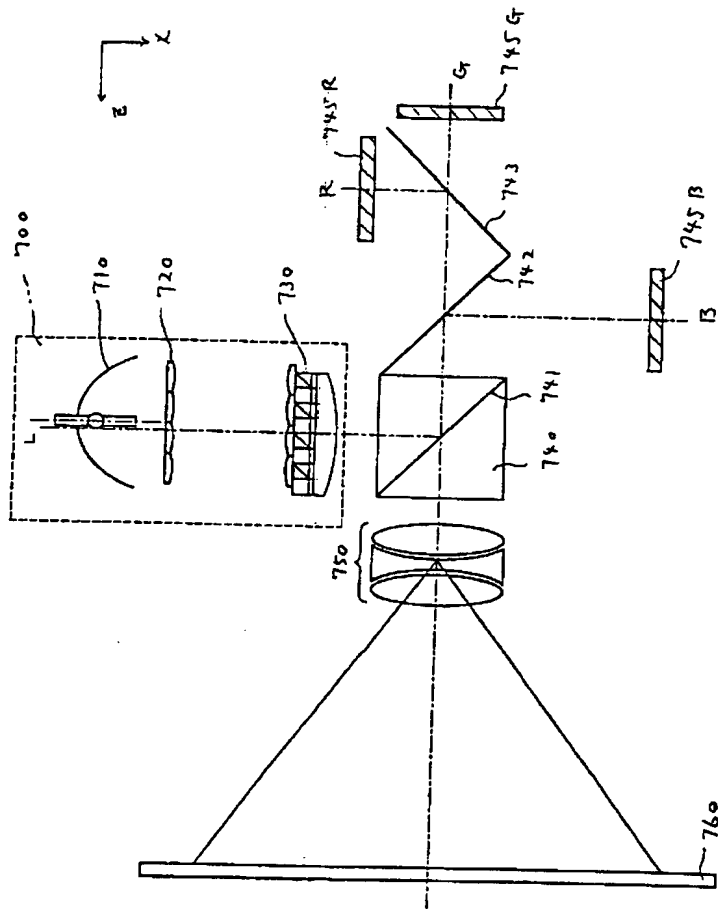
【図 7】



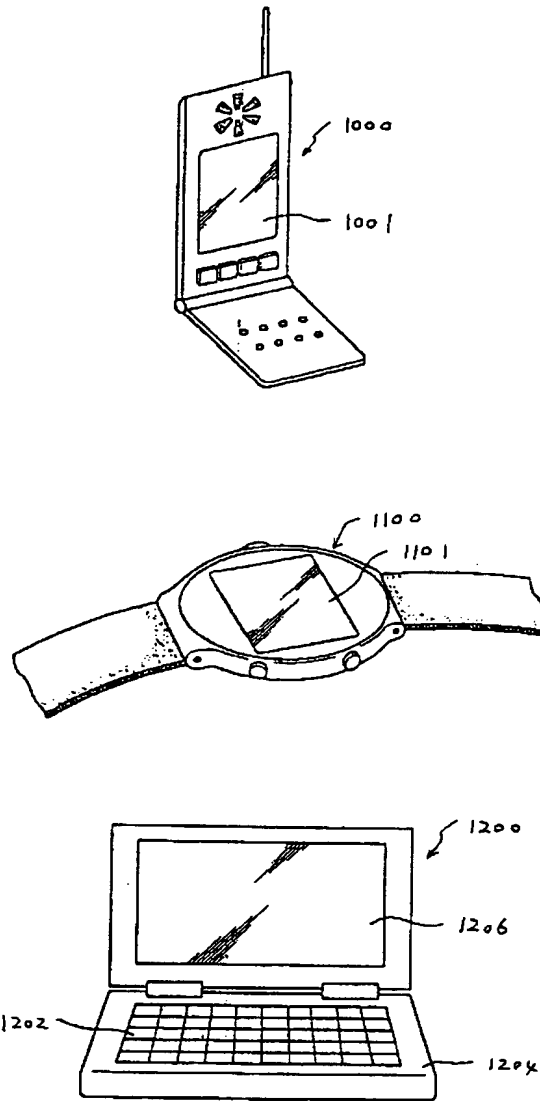
【図 8】



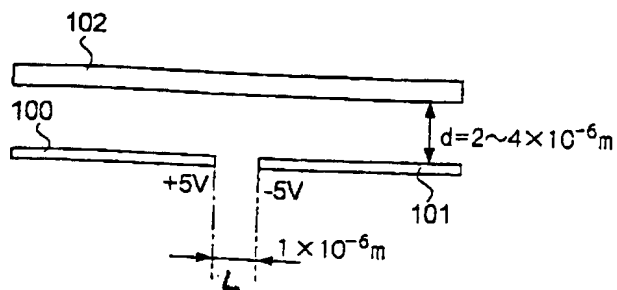
【図9】



【図 10】

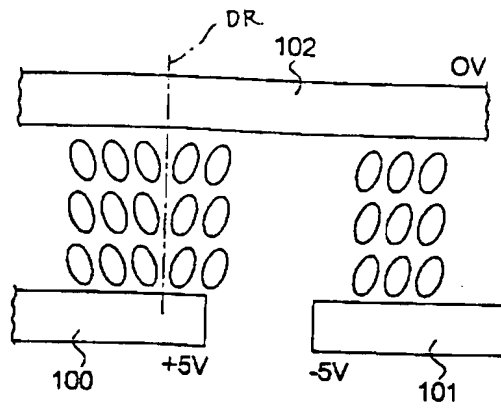


【図 11】

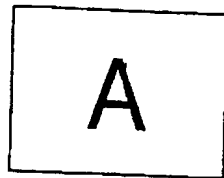




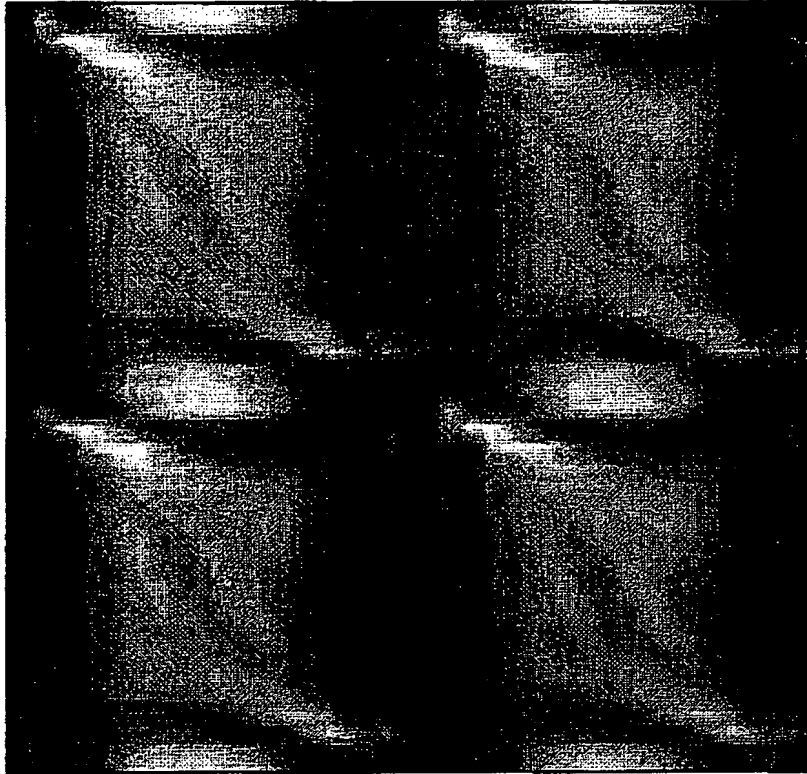
【図 1 2】



【図 1 3】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、高精細な投射型の液晶パネルに対してディスクリネーションに起因する表示欠陥を生じないようにして高コントラストな表示を可能とした液晶装置及び投射型表示装置の提供を目的とする。

【解決手段】 本発明は、一方の基板 1 0 と他方の基板 2 0 との間に液晶層 5 0 が挟持され、このうち、基板 1 0 上に、マトリクス状に配置された画素電極 9 a と、該複数の画素電極を各々駆動する T F T 3 0 が設けられている。ここで、基板間の液晶の厚さを  $d$ 、基板面の液晶配向角（プレチルト角） $\theta_p$  とし場合に、 $20^\circ \leq \theta_p \leq 30^\circ$ 、 $1 \leq d/L$  の関係を満足させる。

【選択図】 図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
氏 名 セイコーエプソン株式会社